

中国半导体行业协会半导体分立器件分会

中半器协 [2017]003 号

第三届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会

为推动我国新型功率半导体器件技术水平进一步提高，加快其成果转化和应用推广，提高自主创新能力。由中国半导体行业协会分立器件分会和株洲中车时代电气股份有限公司共同主办的“第三届全国新型功率半导体器件及应用技术研讨会”于 2017 年 11 月 24 日在湖南长沙召开。本会议是继厦门、昆明成功举办后，全国新型功率半导体器件及应用领域又一次重要的学术、技术交流活动，将为广大从事新型功率半导体材料、器件及其应用技术工作者提供一个高起点、大范围、多领域的交流平台，增进产、学、研之间的技术交流，相互学习，共同提高。为此大会组委会热忱欢迎广大企业、科研院所、高等院校从事新型功率半导体材料、器件及应用技术的相关领域人员，以及相关配套应用的电子专用设备供应商共赴盛会，交流分享自己的应用经验与开发成果。

畅通、共享、共赢——全球化背景下的新型半导体器件及应用技术

一、会议特邀报告

会议将邀请以下著名学者和专家作特邀报告：

株洲中车时代电气股份有限公司副总工程师	刘国友 教授
浙江大学电气工程学院	盛 况 教授
南京银茂微电子制造有限公司总经理	庄伟东 博士
电子科技大学微电子与固体电子学院	李泽宏 教授
英飞凌科技中国有限公司工业功率控制事业部高级经理	陈子颖 先生
专用集成电路重点实验室	冯志红 研究员
苏州能讯高能半导体有限公司技术总监	裴 轶 博士
黄河上游水电开发有限责任公司工程技术部	孙玉泰 先生

二、会议组织机构

指导单位：中国半导体行业协会

主办单位：中国半导体行业协会分立器件分会

株洲中车时代电气股份有限公司

承办单位：新型功率半导体器件国家重点实验室
专用集成电路重点实验室
河北普兴电子科技股份有限公司
中国电子科技集团公司第十三研究所

协办单位：合肥锐拓科技信息服务有限公司
长沙欧信会议服务有限公司
《半导体技术》编辑部
《微纳电子技术》编辑部

三、征文范围

1. 宽禁带（GaN、SiC 等）外延材料的结构设计、制备与检测技术；
2. 功率器件用 GaAs、InP 外延材料的结构设计、制备与检测技术；
3. 基于金刚石、石墨烯的功率器件的结构设计、加工与测试技术；
4. 微波功率器件的结构设计、加工与测试技术；
5. 电力电子器件的结构设计、加工与测试技术；
6. 特种高功率半导体器件的结构设计、加工与测试技术；
7. 功率器件的封装和可靠性技术；
8. 功率器件的系统集成技术；
9. 功率器件及其系统集成的仿真技术；
10. 相关的加工、检验、测试的先进仪器与设备；
11. 功率器件及其电路在电子制造业、网络通信、消费电子、工业控制、汽车电子等领域的应用技术；
12. 功率半导体技术的知识产权保护。

四、论文要求

字数约 600 字论文摘要，完整表述论文的背景、论据和结论，用 A4 纸版面，Word 格式书写，注明作者单位、姓名、简历和联系方式，用电子邮件发送到会议筹备组（polaris13@vip.163.com，csiadd@126.com，文章一经收到，会务组会以邮件回复，如未收到邮件回复，请电话联系会务组予以确认）。

论文详细摘要截稿日期：2017 年 10 月 23 日

论文一经录用，将立即通知作者，请作者准备相应的PPT或PDF演示文件，以备演讲时使用。其论文可以依据作者意愿在中文核心期刊、中国科技核心期刊《半

导体技术》和《微纳电子技术》全文发表，免收审稿费。

五、会议时间和地点

- 1 会议时间：2017 年 11 月 24 日报到，25 日至 27 日开会。
- 2 会议地点：长沙雅士亚华美达广场酒店

六、企业形象和产品宣传

邀请国内外厂商在会议期间参与企业形象和产品的宣传，承办者将以优惠条件提供场所和服务，也可以在《半导体技术》、《微纳电子技术》刊登广告。

（第二轮会议通知将在 11 月初发出，其中将介绍会议详细安排、会议议程、论文题目及报告人等事宜。）

会议联系单位：中国半导体行业协会分立器件分会秘书处

（石家庄市合作路 113 号 中国电子科技集团公司第十三研究所）

联系人：李 永 电话：0311-87091519 手机：13933075237

传 真：0311-87091477

电子邮件：polaris13@vip.163.com

分立器件分会信箱：csiadd@126.com

中国半导体行业协会分立器件分会
二零一七年七月一日

